

High Efficiency Thyristor

$$V_{RRM} = 1200\text{ V}$$

$$I_{TAV} = 30\text{ A}$$

$$V_T = 1,25\text{ V}$$

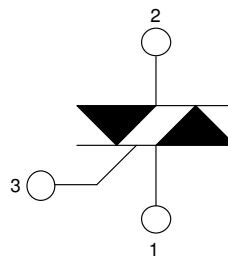
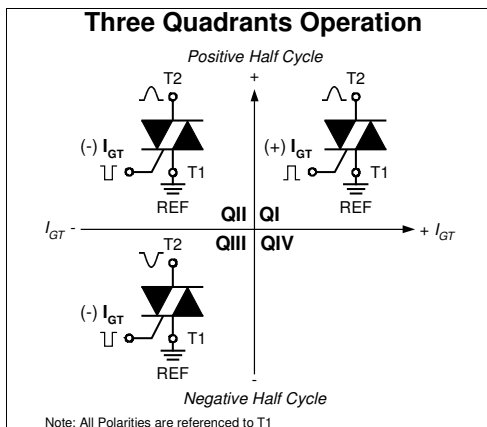
Three Quadrants operation: QI - QIII
1~ Triac

Part number

CLA60MT1200NHB



Backside: Terminal 2



Features / Advantages:

- Triac for line frequency
- Three Quadrants Operation - QI - QIII
- Planar passivated chip
- Long-term stability of blocking currents and voltages

Applications:

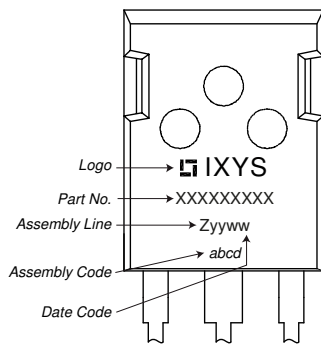
- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: TO-247

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Rectifier			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1300	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1200	V
I_{RD}	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		10	μA
		$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2	mA
V_T	forward voltage drop	$I_T = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1,28	V
		$I_T = 60\text{ A}$			1,56	V
		$I_T = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1,25	V
		$I_T = 60\text{ A}$			1,61	V
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 120^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		30	A
I_{RMS}	RMS forward current per phase	180° sine			66	A
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0,86	V
r_T	slope resistance				12,5	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0,55	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0,25		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		230	W
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		380	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		410	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		325	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		350	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		720	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		700	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		530	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		510	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		25	pF
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30\text{ }\mu\text{s}$	$T_C = 150^{\circ}\text{C}$		10	W
		$t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$			5	W
P_{GAV}	average gate power dissipation				0,5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}; f = 50\text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 90\text{ A}$			150	A/ μs
		$t_p = 200\text{ }\mu\text{s}; di_G/dt = 0,3\text{ A}/\mu\text{s};$ $I_G = 0,3\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 30\text{ A}$			500	A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		500	V/ μs
		$R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)				
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1,7	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$		1,9	V
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		± 60	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$		± 80	mA
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0,2	V
I_{GD}	gate non-trigger current				± 1	mA
I_L	latching current	$t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		90	mA
		$I_G = 0,3\text{ A}; di_G/dt = 0,3\text{ A}/\mu\text{s}$				
I_H	holding current	$V_D = 6\text{ V}$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		60	mA
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		2	μs
		$I_G = 0,3\text{ A}; di_G/dt = 0,3\text{ A}/\mu\text{s}$				
t_q	turn-off time	$V_R = 100\text{ V}; I_T = 30\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ $t_p = 200\text{ }\mu\text{s}$		150		μs

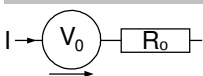
Package TO-247			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0,8		1,2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking

Part description

- C = Thyristor (SCR)
- L = High Efficiency Thyristor
- A = (up to 1200V)
- 60 = Current Rating [A]
- MT = 1~ Triac
- 1200 = Reverse Voltage [V]
- N = Three Quadrants operation: QI - QIII
- HB = TO-247AD (3)

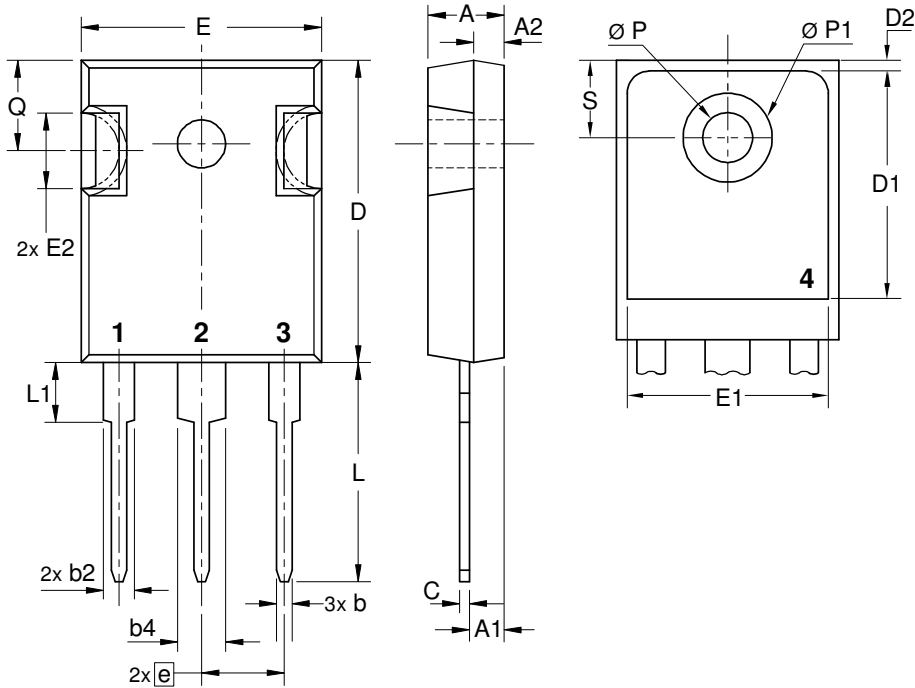
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CLA60MT1200NHB	CLA60MT1200NHB	Tube	30	512073

Similar Part	Package	Voltage class
CLA60MT1200NHR	ISO247 (3)	1200
CLA60MT1200NTZ	TO-268AA (D3Pak)	1200

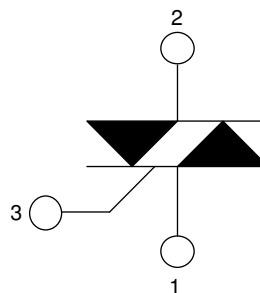
Equivalent Circuits for Simulation
** on die level*
 $T_{VJ} = 150\text{ °C}$

Thyristor

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0,86	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	10	mΩ

Outlines TO-247



Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.215 BSC		5.46 BSC	
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212		5.38	
S	0.242 BSC		6.14 BSC	
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39



Thyristor

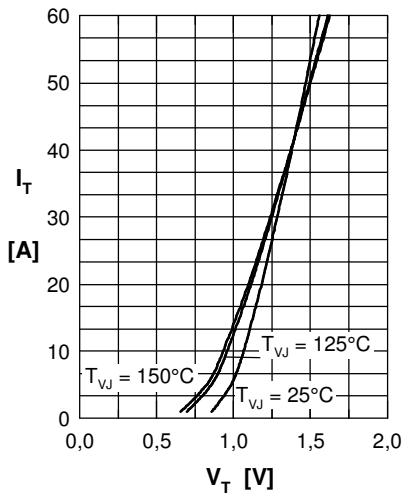


Fig. 1 Forward characteristics

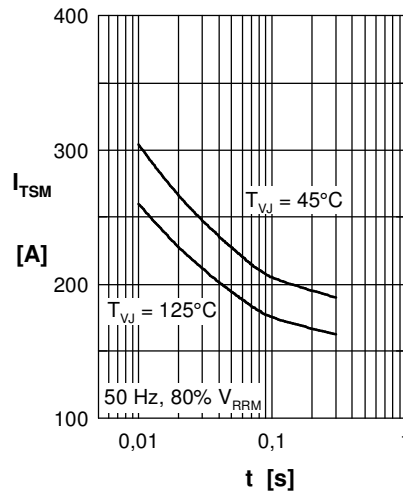


Fig. 2 Surge overload current
 I_{TSM} : crest value, t : duration

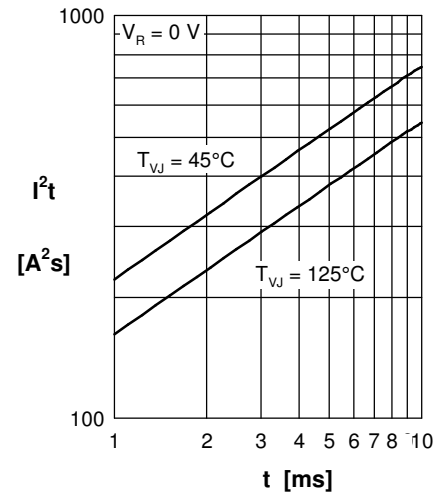


Fig. 3 I^2t versus time (1-10 s)

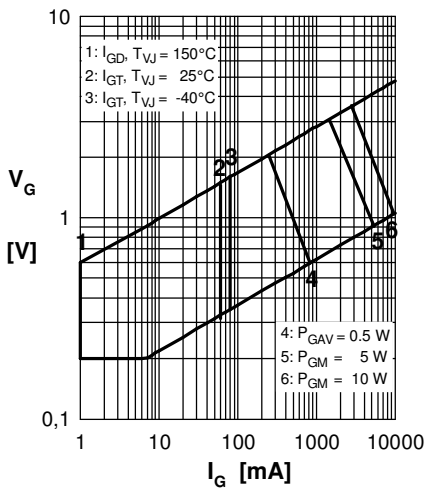


Fig. 4 Gate voltage & gate current

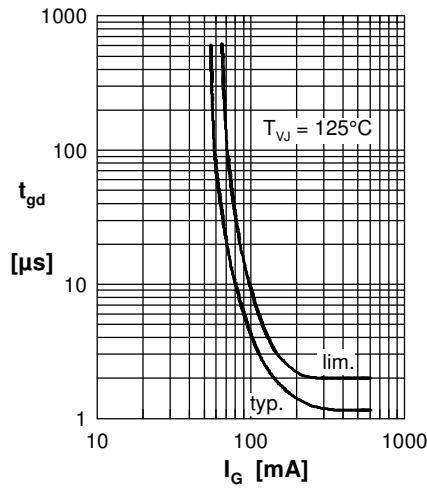


Fig. 5 Gate controlled delay time t_{gd}

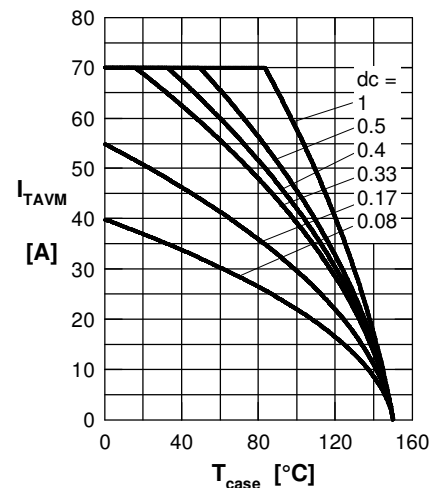


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

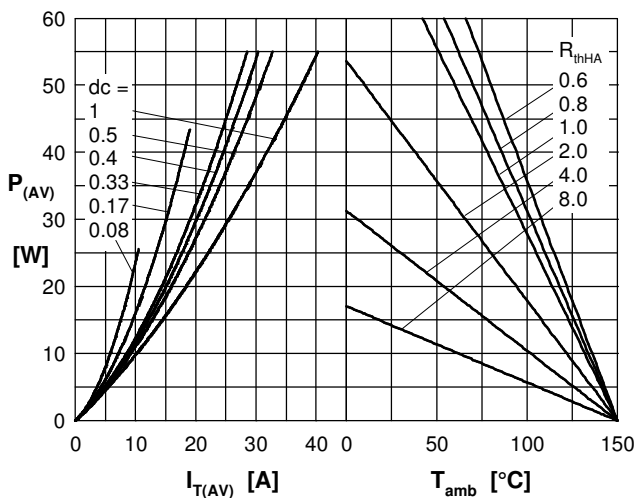


Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
 Fig. 7b and ambient temperature

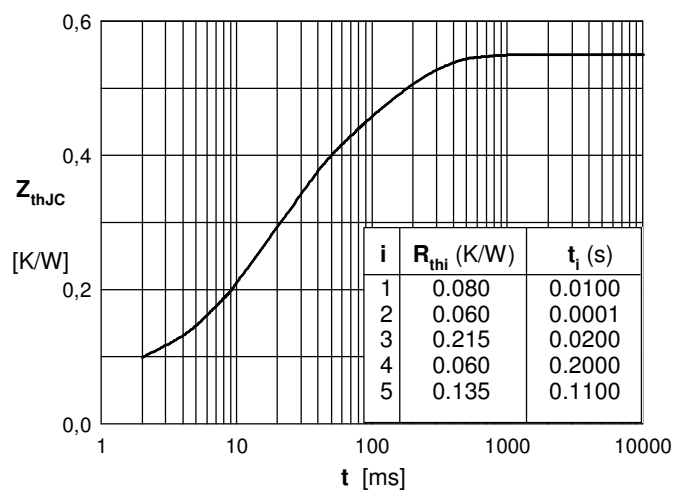


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331